

ТРАНЗИСТОРЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ СВЧ
HIGH-POWER MICROWAVE TRANSISTORS

KT939A, KT939Б

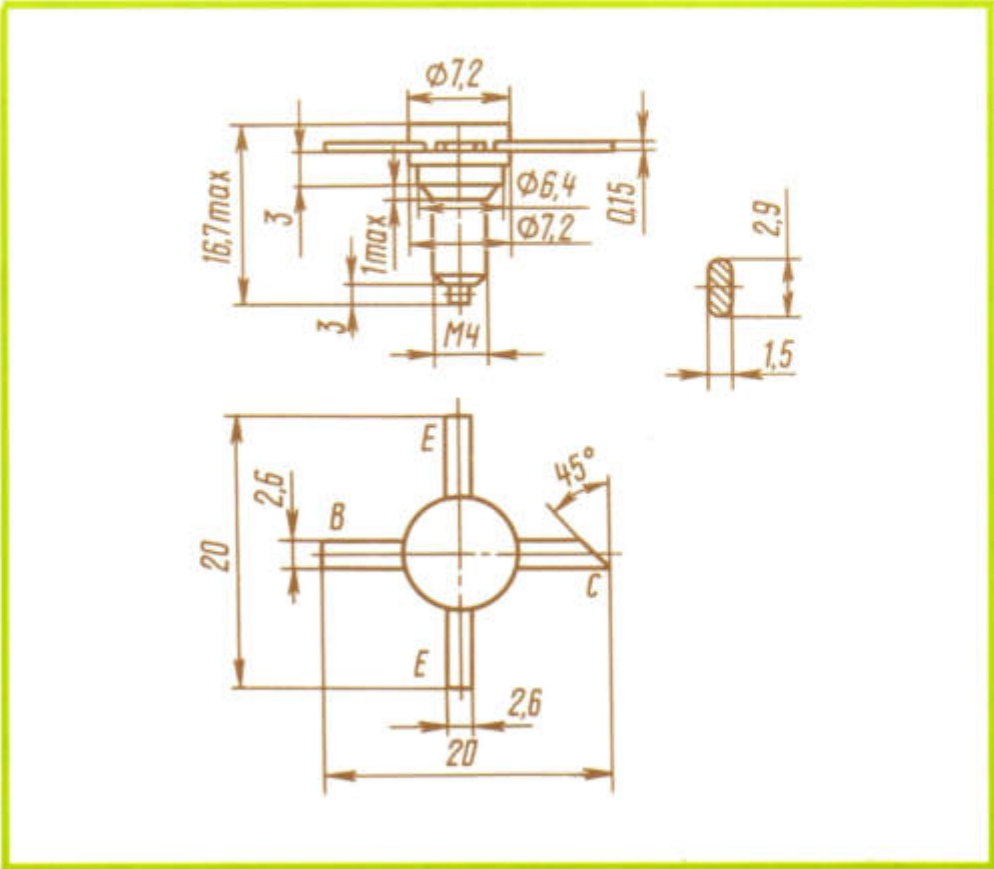
Транзисторы KT939A, KT939Б предназначены для работы в схемах усиления с повышенными требованиями к нелинейным искажениям.

Si-n-p-n-EP

The KT939A, KT939Б transistors are designed for use in amplifier circuits with low distortion nonlinear.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{case} = -60...+100^{\circ}C$
MAXIMUM RATINGS

$U_{CB\ max.} (t_{case} > 25^{\circ}C), V$	30
$U_{CE\ max.} (t_{case} > 25^{\circ}C, R_{BE} = 10\ \Omega), V$	30
$U_{EB\ max.}, V$	3,5
$I_C\ max., mA$	400
$P_C\ max. (t_{case} \leq 25^{\circ}C), W$	4
$t_j\ max., ^{\circ}C$	150



КТ939А, КТ939Б

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	КТ939А	КТ939Б	Режимы Conditions
1	2	3	4
I_{CBO}, mA	≤ 1	≤ 2	$U_{CB} = 30 \text{ V}$
I_{EBO}, mA	$\leq 0,5$	≤ 1	$U_{EB} = 3,5 \text{ V}$
h_{21E}	40–200	20–200	$U_{CB} = 12 \text{ V}$ $I_E = 200 \text{ mA}$
C_c, pF	$\leq 5,5$	≤ 6	$U_{CB} = 12 \text{ V}$ $f = 10 \text{ MHz}$

1	2	3	4
f_T, MHz	≥ 2500	≥ 1500	$U_{CE} = 12 \text{ V}$ $I_C = 200 \text{ mA}$
τ_c, ps	≤ 9	≤ 10	$U_{CB} = 10 \text{ V}$ $I_E = 50 \text{ mA}$ $f = 30 \text{ MHz}$
$U_{(L)CE0}, \text{V}$	≥ 18	≥ 18	$I_E = 30 \text{ mA}$ $I_B = 0$
C_e, pF	≤ 23	≤ 23	$U_{EB} = 0$ $f = 10 \text{ MHz}$

